# Guía de Lenguajes de Interfaz

#### Antonio Emiko Ochoa Adame

19 de febrero de 2019

## 1. Importancia del lenguaje Ensamblador

Si se entiende el lenguaje ensamblador se pueden hacer programas eficientes porque puede ver qué se está programando y relacionarlo con ensamblador.

Esto es fácil de ver en lenguajes de medio nivel (como C) donde es fácil de apreciar cómo sería dicho código, pero en ensamblador.

## 2. Lenguaje Máquina

Es el lenguaje que entiende el procesador, es decir, unos y ceros (1s y 0s).

# 3. Lenguaje Ensamblador

Es el lenguaje que es más fácil de entender para el programador.

El lenguaje ensamblador está basado en nemónicos.

Aprender el código de cada intrucción es muy complicado para el programador, así los **nemónicos** son usados en su lugar.

Nemónicos.- Palabras cortas que dan una idea de la instrucción.

Ejemplos de **nemónicos**: ADD (suma), LD (cargar), sub (restar).

**OPCODE** (Código de operación).- Lenguaje que entiende el procesador e indica la instrucción a realizar.

Dos procesadores son **compatibles** (equivalentes) si tiene el **mismo núme-**ro de instrucciones y el mismo OPCODE para la misma intrucción.

## 4. Memorias

- Secuencial
- No secuencial
- Volátil
- No volátil (ROM)

#### 4.1. Clasificación de memorias

#### 4.1.1. Memoria secuencial y no secuencial

Para acceder a una determinada posición de una localidad un una memoria secuencial, es necesario pasar por las localidades adyacentes.

Ejemplos: Cassettes (se tenía que rebobinar).

#### ¿Cómo funcionan las memorias actuales?

Tienen un bus de direcciones donde se indica la localidad a accesar (no secuencial).

#### 4.1.2. Memoria volátil y no volátil

Memoria volátil.- La información se mantiene siempre y cuando esta se mantenga energizada; La información se pierde si se elimina el voltaje.

Memoria no volátil.- La información se mantiene aún sin voltaje.

#### 4.1.3. Memoria estática y dinámica

La memoria **RAM** se divide en:

- lacktriangle Estática ightarrow utiliza **transistores**
- Dinámica → utiliza capacitores

#### Memoria estática

Mientras se encuentre energizada la información se mantiene.

Está basada en transistores.

#### Memoria dinámica

Además de estar energizada, se requiere refrescar la información para no perderla.

Está basada en capacitores. Un capacitor pierde su carga con el tiempo.

El sistema operativo es el encargado de leer y escribir a información de esta memoria; esto se hace cientos de veces por segundo.

Bit en una memoria dinámica:

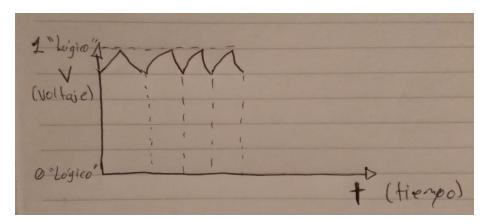


Figura 1: Refresco de bit

En la figura 1 se puede observar cómo el sistema operativo lee el bit de información y lo vuelve a escribir.

### 4.2. Memoria ROM

- EPROM
- E<sup>2</sup>PROM
- Flash

#### 4.2.1. Memoria EPROM (Programable eléctricamente)

Solo puede programar bits en un cambio de  ${\bf 1}$  a  ${\bf 0},$  pero no puede convertir de  ${\bf 0}$  a  ${\bf 1}$ 

Proceso de borrado.- Poner los bits en 1. (se borra con luz UV).

Se caracteriza por tener una ventan de cuarzo transparente para que la luz UV pueda entrar y así borrar la información (poner los bits en 1). Posteriormente, con un programador se ponen los bits deseados a 0.

En las PCs antiguas, el BIOS tenía una memoria EPROM donde se cubría la ventana con cinta negra para evitar la luz UV.

### 4.2.2. Memoria E<sup>2</sup>PROM (Programable y borrable eléctricamente)

Con el mismo programador se pueden poner los bits a 0 y a 1 (borrar).

Cualquier localidad de memoria puede programarse de manera individual.

#### 4.2.3. Memoria Flash

Es muy parecida a la  ${\rm E^2PROM}$  porque puede borrarse y programarse de manera elétrica.

Permite mayor densidad de información.

Es más económica.

#### Desventaja:

No se puede programar una localidad de manera independiente; se tiene programar un **bloque (o página)** completo.

Ejemplo de cómo se modifican las memorias:

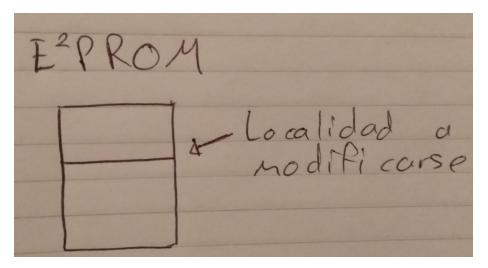


Figura 2: Memoria  $E^2PROM$ 

En la figura 2 se muestra cómo simplemente se modifica la localidad deseada sin ningún problema.

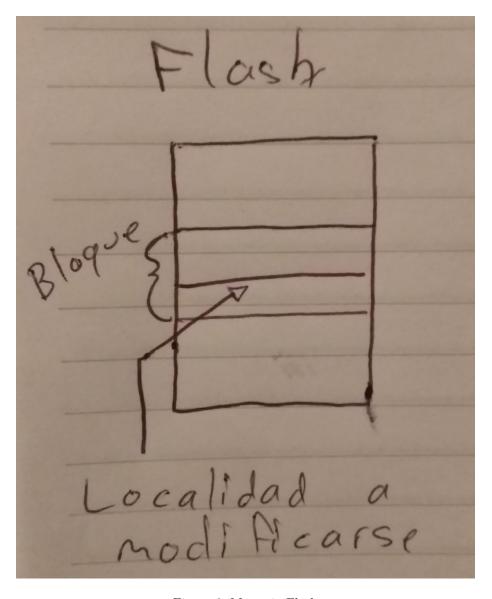


Figura 3: Memoria Flash

En la figura 3 se muestra cómo es el proceso de escribir en este tipo de memoria; hay tres pasos:

- 1. Se leen 512 bytes
- 2. Se modifica la localidad deseada
- 3. Se escribe el bloque completo (los 512 bytes)

**Disclaimer**: La finalidad de este documento es servir como apoyo de estudio. El autor de la versión original de este documento no se hace responsable del uso indebido del mismo.